## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-035504

(43)Date of publication of application: 02.02.2000

(51)Int.CI.

G02B 3/00 G09F 9/00

(21)Application number: 10-279439

(71)Applicant: SEIKO EPSON CORP

(22) Date of filing:

14.09.1998

(72)Inventor: NISHIKAWA HISAO

(30)Priority

Priority number: 10145108

Priority date: 11.05.1998

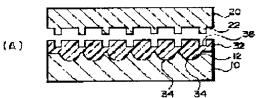
Priority country: JP

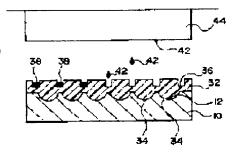
# (54) MICROLENS ARRAY SUBSTRATE AND ITS PRODUCTION AS WELL AS DISPLAY DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a microlens array substrate which may be brightened in a screen and in addition, may be improved in contrast and a process for producing the same as well as a display device.

SOLUTION: This process includes a stage for forming a substrate 32 having plural lenses 34 formed by curved surface parts 12 and plural recessed parts 36 formed by projecting parts 22 by tightly adhering a substrate precursor between a first master disk 10 having the plural curved surface parts 12 and a second master disk 20 having the plural projecting parts 22, a stage for peeling the first and second master disks 10, 20 from the substrate 32 and a stage for packing a light shieldable material 42 into the recessed parts 36 after at least the second master disk 20 is peeled.





### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

# (19)日本国特許广(JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-35504 (P2000 - 35504A)

(43)公開日 平成12年2月2日(2000.2.2)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		識別記号	FI			テーマニード( <b>参考</b> )
G 0 2 B	3/00		G 0 2 B	3/00	A	5 G 4 3 5
G09F	9/00	3 3 6	G 0 9 F	9/00	3 3 6 E	

### 審査請求 未請求 請求項の数22 FD (全 15 頁)

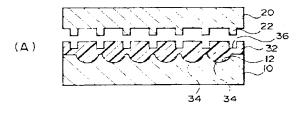
(21)出願番号	特願平10-279439	(71) 出顧人 000002369
(22)出顧日	平成10年9月14日(1998.9.14)	セイコーエプソン株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
		(72)発明者 西川 尚男
(31)優先権主張番号	特願平10-145108	長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ
(32)優先日	平成10年5月11日(1998.5.11)	ーエプソン株式会社内
(33)優先権主張国	日本(JP)	(74)代理人 100090479
		弁理士 井上 一 (外2名)
		Fターム(参考) 5C435 AAO1 BB12 CC09 GC02 HH20
		K407

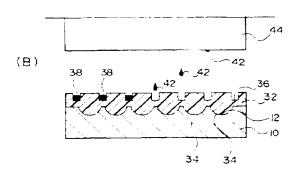
#### (54) 【発明の名称】 マイクロレンズアレイ基板及びその製造方法並びに表示装置

#### (57)【要約】

【課題】 画面を明るくすることに加えてコントラスト を向上させることもできるマイクコレンズアレイ基板及 がその製造方法並びに表示装置を提供することにある。

【解決手段】 複数の曲面部12を有する第1の原盤1 0 と、複数の凸部22を有する第2の原盤20と、の間 に基板的駆体30を密着させて、曲面部12にて形成さ れた複数のレンズ34と、凸部22にて形成された複数 7.四部36とを有する基板30とを形成する工程と、基 枚32から第1及び第2の原盤10、20を剥離する工 程と、小なくとも第2の原盤20が剥離された後に、凹 部36に遮光性材料40を充填する工程と、を含む。





#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の曲面部を有する第1の原盤と、複数の高部を有する第2の原盤と、の間に基板前駆体を寄着させて、前記曲面部にて形成された複数のレンズと、前記凸部にて形成された複数の凹部とを有する基板を形成する工程と、

前記基板がら前記第1及び第2の原盤を剥離する工程

小な「とも前記簿との原盤が剝離された後に 前記凹部 に應光性材料を充填する工程と、

を因むマイプロレンプアレイ基板の製造方法。

【請求項で】 請求項(記載のマイクロ)、アアレイ基 板の製造方法において、

前記曲面部の中心を避けた領域に前記凸部を対向させ て、前記第1及び第2の原盤の間に、前記基板前駆体を 窓着させるマイクロレンファンイ基板の製造方法。

【請求項3】 請求項1又は請求項ご記載のマイクロレップでレイ基板の製造方法によりて、

前部回部に充填された前部遮洗性材料及で前記い。ズの うち生な「とも一方の上に、保護膜前駆体を載せて、前 部保護膜前駆体を固化して保護層を形成する工程を含む マイラコレングアレビ基板の製造方法。

【請求項4】 請求項3記載のサイクロレンスアレイ基板の製造方法において、

前記保護膜前駆体は、エアルキーの付与により硬化可能 力物質であるマチングレンフアンで基板の製造がは。

【請求項3】 請求項4記載のマイドロレックアレイ基 板の製造方法において、

前記エネルギーは、光及で熱パルな(ともいすれか一方 であるマイクロレンズアレイ基板の製造方法。

【請求項6】 請求項5記載のマイフコレンスアレイ基板の製造方法において、

前記保護膜前駆体は、紫外線硬化型樹脂であるマイクロ よいでアルイ基板の製造方法。

【請求項7】 請求項3から請求項6のいすれかに記載 でいるのロシングアミイ基板の製造方法において、

前記保護膜前肌体上に補強板を載せてから前記保護膜前 脈体を固化するマイニコレンプアンイ基板の製造方法。

【請求項8】 請求項11とに請求項7ついづかかに記載 でいるクロ10 アアレビ基板の製造方法において

前記基板前駆体は、エネルキー( 対手により硬化可能な 物質であるマイクコレンファント基板の製造方法。

【請求項9】 請求項8記載のマイクロレッドアレイ基 板の製造で出ておいて。

部記エキルギーは、光及で熱力がなくともいけれた一方であるマイプコレンプアレイ基板の製造方法。

【請主項10】 - 請主項0記載のマイクロロンズアレイ 基板の製造方法において

町記基板前駆体は、紫外線硬化型樹脂でもミマイクロレ シズアレイ基板の製造方法。 【請求項11】 請求項1から請求項10のいずれかに記載のマイクロレンズアレイ基板の製造方法において、前記問部に 前記應配性材料をインクジュート方式によって充填するマイクロレンズアレー基板の製造方法。

【請主項10】 請主項1から請求項:1のいでれかに 記載のマイクロレンプアレイ基板の製造方法において、 前記判部は、底面よりも開口部の面積が大きっならよう に、小なくとも内側面の一部がデースにて形成されてい うマナクロレンプアレイ基板の製造方法。

【請す項13】 - 請す項18記載の中・コロンシベアレイ基板の製造方法にはいて、

前記テージは、内側面の開口端部の本に形成されている マイクロシンプアレー基板の製造方法。

【請本項14】 一方の面に複数のシンツが形成されるとともに、他方の面において前記にいでの4なくとも中心を避ける位置に対応して複数の四部が形成され、前記四部に進元性層が形成されたマイクロシンファン・基板。

【請注項1:5】 請求項1:4記載のマイフロレンデアレイ 基板において、

前記り、7及び前記避光性層の小な「とも一方の上に保護膜を有するマイクロレンズアレイ基板。

【請求項1.6】 請求項1.5記載のマイクロレンプアレイ基板において、

前記保護購上に補強板を有するマイフロレジステレイ基 板。

【請求項17】 請求項14から請求項16でしてわか に記載のマイクコレンスアレイ基板において、

前記門部は、底面よりも関口部の面積が大きしなるように、そなくとも内側面の一部がデージにて形成されているマイクロシンフアレイ基板。

【請求項18】 請求項17記載のマイクコレックアレイ基板において、

前記デーバは、白側面の開口端部のみに形成されている。 マイクロレンスアレイ基板。

【請ぶ項19】 請求項1から請求項130円 (すたかに 記載 (方法により製造されるマイクロ) 、スプリイ基 板。

【請り頃20】 請求項14から請求項10でしてわか に記載のマイクロレンスアレイ基板と、前記マイクロシンズでは不基板に向いて売売運動から先額と、を有し 前記サークロレンプアレイ基板は、前記は17万円成さ れた面を開記先額に向けて配置される表示装置。

【請れ頃21】 請れ頃20記載の表が装置におして前記マイプロ1. アアレイ基板を構成する材料の光屈折率na 。前記し2.7 の外側における光屈折率nb とは、na nb に関係にあり、前記レンフは凸り1. ズであると示数数。

【請求項と2】 請求項20記載の表示字置において 前記コイクコレンズアレイ基板を構成する材料の光層板 楽na と、前記シンスの熱側における光品折楽nb とは、na くnb の関係にあく、前記シンゴは河レンゴである表示装置。

【発明で詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】 料発明は、マイココレンスアン・基板及びその製造方法並びに表示装置に関する。

[0002]

【発明の背景】これまでに、複数の微小なシンズが並べられて構成されるマイクロレンズアレイが、例えば夜晶パネルに適用されてきた。マイクロレンブアレイを適用することで、各シンズによって各画素に入射する光が集光するので、表示画面を明るくすることができる。

【0003】また、マイクコレンズアレナを製造する方法として、トライエッチング法又はウェットエッチング法を適用する方法が知られている。しかし、これらの方法によれば、個サのマイクコレンズアンナを製造する毎に、リソクラフ・工程が必要であってコストが高くなる。

【0004】そこで、特開中3-198003号公報に 開示されるように、レンズに対応する曲面が形成された 原盤に樹脂を滴下し、この樹脂を固化させて剥離するこ とで、マイクロレンズアレイを製造する力法が開発され できた。

【0005】マイクコレンプアレイは表示画面を明るくするものであるが、画楽間エコントラストを向上させるものではない。こたがって、明るくで鮮やかな画面を表示するには、マイクコレンプアレイに加えて、コントラストを向上させる手段が必要となる。従来のマイクコレンプアレイの製造方法では、コントラストを向上させることが考慮されていなかった。

【0006】本発明は、ことような問題点を解決するもので、その目的は、画面を明るくすることに加えてコントテストを向上させることもできるマイクコレンズアレイ基板及びその製造方法並びに表示装置を提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】 1: 本発明に係るマイクロレンプアレイ基板の製造力法は、複数の曲面部を有する第1の原盤と、複数の曲部を有する第2の原盤と、の間に基板前駆体を密着させて、前記曲面部にて形成された複数の世紀とを有する基板を形成する工程と、前記基板から前記第1及び第2の原盤を剥離する工程と、少なくとも前記第2の原盤が剥離された後に、前記回部に進元性材料を充填する工程と、を含む。

【0005】本発明によれば、第1及び第2、原盤作間に基板的駆体を密着させて、第1の原盤・曲面部を転写してレンゴを形成する。こうして、複数のレンズが形成されたマイケロレンスアンド基根を簡単に製造すること

かできる。各シンスによって入射光が集光するがて画面を明る。することができる。また、第1及び第2の原盤は、一旦製造すればその後、耐気性の許す限り何度でも使用できるため、2枚目以降のマイクロシンズアンイ基板の製造工程において省略でき、工程数の減少およが低コスト化を図ることができる。

【0009】さらに、これマイクロレンスアレイ基板には、第2の原盤の凸部によって、空部が転写形成されており、この凹部に遮光性材料が充填される。この遮光性材料は、ブラックマトリクスを構成し、画素間のコントラストを向上させることができる。

【0010】 このように、本発明によれば、画面を明るくすることに加えてコントラストを向上させることもできるマイクコンンズアンイ基板を、転写法によって簡単に製造することができる。

【0011】(2) この製造方法において、前記曲面部の中心を避けた領域に前記凸部を対向させて、前記第1及び第2の原盤の間に、前記基板前駆体を密着させてもよい。

【0012】こうすることで、マイクロレンズアレイ基板に形成される凹部は、レンズの中心を避けた領域に形成されるので、レンズの中心を避けてブラックマトリクスを形成することができる。

【0013】(3) この製造方法は、前記凹部に充填された前記遮光性材料及び前記シンズのうち少なくとも一方の上に、保護膜前駆体を載せて、前記保護膜前駆体を固化して保護層を形成する工程を含んでもよい。

【0014】 (4) 前記保護膜前駆体は、エネルギーの付与により硬化可能な物質であってもよい。

【0015】 (ミ) 前記エネルギーは、先及び熱の少な くともいずれか一方であってもよい。

【① 0 1 6 】 (6) 前記保護膜前駆体は、紫外線硬化型 樹脂であってもよい、

【0017】(7) この製造方法において、前記保護膜 前駅体上に補強板を載せてから前記保護膜前駆体を固化 してもよい。

【0018】(8) 前記基板前駆体は、エネルギーのけ 与により硬化可能な物質であってもよい。

【0019】このような物質を利用することで、第1及び第2人原盤上の微細部にまで基板前駆体を容易に充填することができ、したがって、第1及び第2原盤上の曲面部及び凸部の形状を精密に転写したマイクロレンズアレイ基板を製造することが可能となる。

【0000】 - 9 - 前記エネッキーは、光及が熱力少な くともいずかが一方できってもより。

【0021】こうすることで、汎用と露光装置やベイフ が、エットコンートが利用でき、低設備コスト化、省ス ベース化が可能できる

【0022】 10 前記基板前駆作は、紫水線硬化型 横能であってもよ。 【0023】紫色線硬化型樹脂としては、アクリル系樹脂が透明性に優れ、様々な市販の樹脂や膜光剤を利用することができるため好適である。

【0024】(11)ごの製造方法において 前記四部 に 前記遮光性材料をインクジェット方式によって充填 上でもよい。

【0025】インでジョンミガ式によれば、遮光性材料で充填を高速化できるとともに無駄にすることがない。

【0026】「12)この製造方法において、前部関部は、庭面よりも開口部の面積が大きくなるように、生金でとも内側面で一部がデージにて形成されていてもよい。

【0027】このように囲部をデーバ状に形成すれば、 遮光性材料を確実に囲部に導っことができるため、製造 されるサイクロい。デアンイ基板は、特に高解像度の液 晶パネルに適している。

【0028】 - 13)この製造方法において、前記ホースは、内側面の開口端部のみに形成されていてもよい。

【0029】このように凹部を形成すれば、遮光性材料の厚さの差が小さいため、遮光性能がよい化されるので、製造されるマイクロレングでレイは、鮮明な画像を提供することができる。

【① 0 3 0 】 (1 4) は発明に任るマイニロシングアシイ 基板は、一方の面に複数の1 シアが形成されるとともに、他方の面において節記し、パの少なことも中心を避ける位置に対応して複数の凹部が形成され、部記凹部に渡光性層が形成される。

【0031】本発明によれば、名シンプによって入射光が集光するので画面を明らくてきることに加えて、凹部に元成される進光性層がブラックマトリファとなって、画素間のコントラフトを向上させることができる。

【0082】 (1.5) このマイクロレックアレイ基板に はいて、前記レップ及び前記遊光性層の少なくとも一方 の上に保護膜を有してもよい。

【りり33】 (18) このマイニコレンファレイ基板において、前記保護購上に補強板を有してもよい。

【0034】(117) このマイフコレンフアンイ基地に まいて、前記四部は、廃棄よれも開口部の面積が大き点 なるように、よな「とも内側面の一部がデースにで开放 されていてもよい。

【0035】このディフロレンデアレイ基板は、関部の 開口部が面積が底面より大きになっていることがで、燃 元性材料が確実に関部に導かするでで、特に高解像度の 液晶パネルに適している。

【① 0 3 6】 (13) まわっとつロレングアレイ基板に おいて 前記デージは 内側値に関ロ端部にみに形成されていてもよい。

【0007】このように凹部を形成すれば、遮光性材料 に厚さの差が小さいために、遮光性能が初っ化されるので、鮮明な画像を提供することができる。 【0038】 (19)本部明に係るマイクロレンズアレ イ基板は、上記方法により製造される。

【0 0 3 9】 (2 0) 本証明に係る表子装置は、上記ディケロレンズア: イ基板と、前記マイクロレンズアにイ基板に向けて光を照射する必須と、を有し、前記マイクロレンズアレイ基板は、前記レンズが形成された面を前記光源に向けて配置される。

【①ロ40】(②1)前記マイプロレンプアレイ基板を構成する材料の光層折至na と、前記レンざつ外側における光層折至nbとは、na nbで関係にあり、前記レンブは凸レ、ずであってもよい。

【10041】屈折率の小さい媒質が多、屈折率の大きい 媒質に売が入射すると、光は両媒質の界面の法線に近づ にように屈折する。したがって、マイフロンシズアンと 基板を構成する材料の光層折率na と、1007の外側に おける光展折率nb とが

na · nb

の関係にある場合には、レンプを凸りしてにすることで 入射した光を集光させることができる。

【0042】 (22) 前記マイプロレアスアレ子基板を構成する材料の光屈折導 na と、前記してプロ外側における光屈折導 nb とは、na ・ nb の関係にあり、前記してスは関いしてであってもよい。

【0043】屈折率力力きい媒質が1、屈折率の小さい 媒質に光が入射すると、光は両媒質の界面の法線から遠 ぶかるように屈折する。したかって、マイクロレンファ 1 子基板を構成する材料の光密折率 na に、レンプの外 側にはける光麗折率 nb でか。

nar nb

の関係にある場合には、いいでを囲むいえにすることで 入射した光を集光させることができる。

### [0044]

【発明の実施の刑態】以下、は発明の好適な実施刑態に ついて図面を参照にして説明する。

【0045】(第1の実施形態)図1 (A) へ図4 (B) は、第1の実施形態に係るマイクロ1、アアレイ 基板の製造方法を示す因できる。

【りり46】ます、日1 A)にデエように、第1の原盤10及び第2の原盤20を用意する。第1の原盤10には、複数の曲面部12が形成されており、各曲面部12は、凸・17の反転パターンとなるように凹状をなっている。一方、第2の原盤20には、複数の凸部22が形成されている。複数の凸部22は、同分しない平面視にはでして、ブラ・ファントとファの形状をなす。

【10047】第1長で第20万盤10、20は、それそれが曲面部12及で凸部20を対向させて、たべ、各凸部22が曲面部120中心を避けて対向すりように配置されている。

【0048】そして、原盤10±原盤20±の間に、基 板前駆体30(第10上透過性層前駆体)を密着させ る。基板的製体 8.0 は、3.0 に 3.0 に 3.0 で 3.0 大アンイ 基板 8.0 の材料 3.0 なる。 なお、3.0 で 3.0 は、 9.0 の 3.0 に 0.0 で 3.0 に 0.0 に 0.0

【1049】基板的配体、UEしては、マイケコレンファレイ基板3日となった際に、必要とされる光透過性を有していれば特に限定されるものでなり、種々の物質が利用できるが、エスルギーの仕事により硬化可能な物質であることが好ましい。このような物質は、マイケコレンズアレイ基板3日の形成時には低粘性の液状で取り扱うことが可能となり、常温、常圧下あるいはその近傍においても容易に第1及び第2の原盤10、20の微細部にまで容易に光填することができる。

【0030】コネキキーとしては、光及び熱の少な「ともいずれか」がであることが好ましい。こうすることで、汎用の露光装置やベイク炉、ホットプレートが利用でき、低設備ニスト、省ソバース化を図ることができる。

【0051】このような物質としては、例えば、紫体線硬化型樹脂がある。紫外線硬化型樹脂としては、アクリル系樹脂が好適である。様々な市販の樹脂や感光剤を利用することで、透明性に優れ、また、短時間の処理で硬化可能な紫外線硬化型のアクリル系樹脂を得ることができる。

【0052】紫外線硬化型のアクリル系樹脂の基本組成の具体例としては、プレポリマーまたはオリゴマー、モフマー、光重台開始剤があげられる。

【0053】 プレポリマーまたはオリゴマーとしては、例えば、エポキシアクリレート類、ウレタンアクリレート類、ポリエーテルアクリレート類、ポリエーテルアクリレート類、アピコアセタール系アクリレート類、ウレタンメタクリレート類、ポリエステルメタクリレート類、ポリエステルメタクリレート類等が利用できる。

ペンダエッマットージトップで、シート、シベンダエッスットージスキャアダッシート等の多官能性モノマーが 利用できる

【0055】光重合開始剤としては、例えば、2、2・ ジストキシーセップ出出らアセトフェイン等人アセトア まべい類、キャビトロキング 177千シフェイン、pH6 ソプロピルーaーヒドロキシイフプチルフェファ等のブ 手ルフェノン類、pーミeまと=ブチルジクココアセト フェイン pitert-ブチット カココアセトフェ ノン、 4. αージュロレー4ーアエフキシアセトフェブ シ等のハコゲン化アセトフェノン類、ベンソフェノン、 N、NHテトラエチルー4、4-177~2 / ペンパフェノ ン等のペンプフェッン類、ベンジル、ベンジルビメモル たターの等のペンジル類、ペンプィン、ペンジィンアル キルエーテル等のベンゴイン類、1ーフェニルー1、2 ープロペンジオント2~(6~ エ・キシカルガニルにオ キシム等のせキシム類、ローメチルキオキサントン、ロ ークロロチオキサントン等のキサントン類、エピラーケ トン等のラジカル発生化合物が利用できる。

【00056】なお、必要に応じて、酸素による硬化阻害 を防止する目的でアミン類等の化合物を添加したり、塗 布を容易にする目的で溶剤成分を添加してもよい。

【0057】溶剤成分としては、特に限定されるものではなく、種々の有機溶剤、例えば、プロピレングリコールモノメチルエーデルアセテート、プロピレングリコールモノプロピルエーデル、メトキンメチルプロピオネート、エデルセコソルブ、コチルセロソルブでセテート、エチルセコソルブ、コチルピルピネート、メチルアミルケトン、シクコペキナノン、キシレン、トルエン、ブチルアセテート等かを選ばれる一種または複数種の利用が可能である。

【0058】このような紫外線硬化型のアクリル系樹脂等からなる基板前駆体30を、図1、Arにデすように、原盤10上に所定量滴下する。

【0059】モして、図1 18. に示すように、基板前駆体30を所定領域まで拡げ、続いて、図1 10. にかけように、原盤10、10の少なくともいずわか一方から紫外線40を所定量照射して基板削駆体30を硬化させて、原盤10、20の間にマイクコレンズアレイ基板30、20の間にマイクコレンズアレイ基板30、再発板32の一方の面には、複数の曲面部12から転写された複数の凹部36が形成され、他がの面には、複数の凸部22から転写された複数の凹部36が形成されている。複数の凹部36は、図テレない平面視において、プラックマトラウマの形状をなす。また、凹部36に、レンズ34の中心を避ける領域に対応して形式されている。

【2060】基板的駆体30を新定領域までおげるにまたって、変要に溶して所定の圧力を原盤10、20で少なしままった加えてもよい。ここでは、基板的駆体3

のを原盤10上に滴下したが、原盤20に滴下するか 原盤10 20の両方に滴下してもよい。また、ドビニュート法、ディーアング法、アブレーニート法、ニーニニート法等の方法を用いて、原盤10 20のいでわかー方、または、両方に基板前駆は30を 釜布してもよい。

【0061】そして、四2(A)に手すように、原盤2 0を、ディクロシンプアレー基板32から剥離して一面 部22から転写された四部36を開口させる。

【0062】次に、関ビ(F) に示すように、マイクロ レンプアレイ基板30の開部36に適発性材料40を充填し、遮光性層38至形放する。この遮光性層38は、 プラックマトリウスとなる。

【0063】避洗性材料42は、光透過性のない材料であって耐化性があれば種々で材料を適用可能である。例えば、異色染料あるには黒色面料をかって、ダー樹脂とともに溶剤に溶からたものを、避洗性材料42として用いる。溶剤としては、特にその種類に限定されるものではなり、水あるいは種々の有機溶剤を適用することが可能である。有機溶剤としては、例えば、プロビビングリコールモノブロビルエーバル、ノトキ、メデルブロビオオート、エデルセロブルでですが、エデルセロブルでですが、エデルセロブルでですが、エデルセロブルでですが、エデルセロブルでですが、エデルセロブルでですが、エデルセロブルでですが、エデルセロブルでですが、エデルセロブルでですが、エデルセロブルでですが、エデルセロブルでですが、エデルセロブルでですが、エデルセロブルでですが、エデルセロブルでですが、エデルでは多いである。

【0064】明部36への進売性材料42の充填方法としては、特に限定されるものではないが、インフシェット方式が好適である。インフェート方式によれば、インフジェットでリンク用に実用化された技術を応用することで、高速がつインフを無駄な「経済的に充填するとが可能である。

【0065】[図2 (B) には、ボングルエットペッド44によって、進出性材料42を凹部36に充填する様子を添してある。誰しては、四部36に対向させてイングジェットペッド44を配置し、各進出性材料442を各凹部36に吐出する。

【0066】インケジェット、・144は、例えばインフジェットでリック用に実用化されたもので、圧電率をの体積変化を利用してインケに圧力を加えて吐出させるビエイジェー、タイプ、あるいはエネルギー発生素子として電気熱変換体を用いて、インケウ体積を膨脹させたり気化させ、その圧力でイングを吐出するタイプ等が使用可能であり、射出面積ねよび射出がターンは任意に設定することが可能である。

【0067】 お実施形態では、パンクジェッチ・シデ4 4から遮光性が料4つを吐出させる。そのため、遮光性 材料4つには、インタジェット・ッド44からの吐出を 可能とするため、流動性を確保する必要がある。

【10068】遮光性材料42を充填するときには、マイクコレンゴアレイ基板32に形成された凹部36に均一な量で充填されるように、インペジェットへ、ド44を動かす等の制御を行って、打ち込み症置を制御する。即部36の隅をにまで均一に遮光性材料42が満たされたら、充填を完了する。溶剤成分が含まれている場合には、熱処理により遮光性材料42から溶剤成分を除去する。たお遮光性材料42は、溶剤成分を除去する。たお遮光性材料42は、溶剤成分を除去すると収縮するため、必要な遮光性が確保できる原みが収縮液でも残される量を充填しておりことが必要である。

【0069】次に、図3(A)に示すように、ベイフロンンででしょ基板3つ上に保護膜前駆体46(接着層前駆体30として使用できる材料から選ぶことができる。そして、補強板48を保護膜前駆体46に若着させて、この保護膜前駆体46を押し拡げる。なお、保護膜前駆体46は、アピンコートは、ロールコート法等の方法により、マイフロンンでアンゴ基板3つ上に、或いは補強板48上に注り拡げてから、補強板48を富着させてもよい。

【0070】補強板48としては一般にカディ基板分用 いられるか、光透過性で機械的強度等の特性を満足する ものであれば特に限定されるものではない。例えば、補 強板48として、ポリカーボネート、ポリアリレート、 ポニーデルナルでは、、アニルフィアポニョレン・ し、ポリエチレ、デレフタレート、ポリメナルマタッド レート等のプランチーで製の基板を多いはフィルム基板 を用いてもよい。

【0071】そして、保護膜前駆体46つ組成に応じた 硬化処理をすることにより、これを硬化させて、図る

(B) に示すように保護膜50 (接着層) を形成する。 整外線硬化型のアクリル 系樹脂が用いられる場合には、 紫外線を所定の条件により照射することにより、保護膜 前駆体46を硬化させる。

【0072】続いて、図3 (C) に示すように、原盤1 0をマイフロレンアアレイ基板325年剥離する。マイ クロレンアアレイ基板32には、原盤10の曲面部12 によって、レンプ34が形成されている。シンプ34 は、凸レンプである。

【0073】さらに、同4、A)に子でように、マックロシングでして基板32でも、704を頂する値と、補強板54との間に保護膜前駆体52を密着させる。その工程は、図3 A)にデザ工程と同様であり、保護膜前駆体52、第2の光透過性層前駆体)は、保護膜前駆体46として進捗可能な物質の中から選択できる。

【0074】エニして、昭4 B)に原すように、両面に、保護膜50 55及び補強板48、54を備えるマイプロレンドアにオ基板52が得られる。これによれば、レンコ34側から入庫する先が集光するようになっ

-- 2

【9075】なお、保護膜50、56が、マイクコンシステンド基板として要求される機械的強度やガスメニア性、耐薬品性等に特性を満足することが可能であれば、対ですく補強板48、54は不要である。さらに、マイニコンシスアンド基板32日本が十分な強度を有し、遮光性層32が破損することがなければ、保護膜50、56を省略することも可能である。

【0076】保護膜50が形成される場合には、マイクコレンプアンド基板30の光屈折率naと、レンズ34 こ外側に位置する保護膜56を構立する保護膜前駆体5 20光配折率nbとは、

na >r.b

プ関係にあることが必要である。こと条件を満たすことで、屈折率の小さい媒質から、屈折率の大きい媒質に光が大射することになり、光58は両媒質の界面の法線に任べく→でに屈折して集光する。そして、画面を明るくすることができる。

【0077】本実施用能によれば、第1及び第2の原盤 10,20の間に基板前駆体30を密着させて、第1の 原盤10の曲面部12を転写して1ンズ34を形成する。こうして、複数のレンズ34を有するマイクロレン ズアレイ基板32を簡単に製造することができる。この 製造方法によれば、材料の使用効率が高く、かつ工程数の無端を図ることができ、コストダウンを図ることができる。 きる。また、第1及び第2の原盤10、20は、一旦製造すればその後、耐久性の評す限に何度でも使用できるため、2枚目以降のマイクコレンデアレイ基板の製造工程において省略でき、工程数の減少および低コスト化を図ることができる。

【9078】さらに、このマイクコレンプアレイ基板には、第2の原盤200凸部22によって、凹部36が転写形成されており、この凹部36に遮光性材料42が充填される。この遮光性材料42からなる遮光性層38は、ブラックマトリフスを構成し、画素間のコントラストを向上させることができる。

【り079】このように、本実施形態によれば、画面を明るくすることに30分でコントラストを向上させることも、できるマイクコレンプアレイ基板を、転写法によって簡単に製造することができる。

【0080】 「第22 実施形態」図3 1A 〜図6 C は、第2の実施形態に係るマイクコシンでアンイ 基版の製造が出を示す図である

【0081】まず、215 A に示すように、第1 2章 盤110及び第2の意盤207間に、基板前駆体130 を密着させる。第170原盤110には、複数2曲面部1 12が形成されている。曲面部112は、四レレスの関 転パターンとなるように凸状をなしている。本実施形態は、曲面部1127所状において第17実施形態と異なる。一方、第27原盤20は、第17実施形態で使用し たものであり、基板可駆体150も第1実施形態で使用 可能な物質が心選択することができる。そして、図1

こと。同様の工程を経て、マイウロシンズアンイ基板 132を形成する。マイウロシンズアンイ基板132には、凸部221の空部136が転導され、曲面部112 がたシンズ134が転算されている。シンズ134は、空コンズである

【10082】次に、図3 B に示すように、第2の原盤20をマイクロシンズアシイ基板102から剥離して、図3 - C に示すように、四部106に進光性材料を充填して進光性署108を形成する。これらの工程は、図2 (A - 及び図2 (B - に示すし程と同様である。

【0083】続いて、図6 - A. に示すように、マイクロレン ズアレイ基板152における遮光性層158を育する面と補種板148との間に保護膜前駆体(接着層前駆体)からなる保護膜150 - 接着層戸を形成して、図6 - E. に示すように、第1の原盤110をマイクロレンズアレイ基板132から剥離する。モして、図4

・A の工程と同様にして、レンズ104上に保護膜156「第2の光透過性層」及び補強板154を形成する

【0084】以上の工程により、図6 C) に示すように、両面に、保護膜150、156及び補強板148、154を備えるマイクロシンズアレイ基板132が得られる。これによれば、レンズ34側から入射する光が集光するようになっている。

【0085】なお、その前提として、マイクコレンズアンで基板132の光屈折率 na'と、レング134の外側に位置する保護膜156を構成する保護膜前駆体の光屈折率 nb'とは、

na' < nb'

の関係にあることが必要である、この条件を満たすことで、屈折率の大きい媒質から、屈折率の小さい媒質に光が入射することになり、光158は両媒質の界面の法線から離れるように屈折して集光する。そして、画面を明るくすることができる。

【ロ 0 8 6】 本実能形態によっても、土口 シズと関シンスの違いがもそだけで、第 1 の実施形態と同じ効果を達成することができる。

【0087】 第3の実施形態・図7~図5 B は、第5の実施形態に係るマイクロレンズアレイ基板及びその製造方法を示す配である。本実施形態では、図7に示すマイクロレンズアレイ基板200を製造する。マイクロレンズアレイ基板200は、運動2027形形に形式、図20B に示すマイクロレンズアレイ基板32と異なる。すなわれ、匹敵202は、内側面が傾斜したデード形式に形式されている。この図都202によれば、変面に比へ関口節が立くなっているでで、衝素密度が確実しなっても、速光性材料42 区20B 参照 を確実

に充填することができる。この形状の凹部202を形成するこは、断面において台#さな可由部を有する原盤を使用する。

【ロ088】図8(A)~図9(B)は、凹部202を 形成するための原盤を形成する三段を示す図である。

【10081】まず、国8(A)に余中ように、基材21 2上にシジスを層214を形成する。基材212に、表面をエッチンでして原盤とするためのもので。エッチング可能な材料であれば特に限定されるものではないが、シニコン又は有英は、エッチンでにより高精度の凸部の形成が容易であるため、好適である。

【0000】1072日層214を共成する物質としては、例えば、生資体デスイス製造によりて一般的に用いるわている。クロン・ステナーの手動脂に感光剤としてディブナン・キャン誘導体を配合した市販に対し型のレジストをそのまま利用できる。ここで、対じ型のレジストとは、所定のペターに応じて放射線に暴露することにより、放射線によって暴露された領域が現像領により選択的に除去可能となる物質のことである。

【10091】1.75層214を形成するがあるしては、タピ、コート法、ティーピンで法、タブレーコート法、ファールでも法を用いることが同能である。

【0092】次に、[48:38] に示すように、マグラコ 16をレンスを層コ14の正に配置し、マグラコ16を 介してレンスを層コ14の所字領域のみを放射線で19 によって暴露する。マグウコ16は、凸部コココ([49

B) 容脚)の形成に定要とされる領域にはいて、放射線218から整備しないようにパターン形成されたものである。マスト216における放射線連蔽部は、デザックマネリアの使用に応した体制をなっている。デデックマネリアの形状は、モザイク配列、デスタ配列又はストライプ配列などの画素配列に応じたものできる。

【0093】放射線としては波長200mm~500mmの領域の光を用いることが好ましい。この波長領域の流の利用は、液晶にオルの製造ではセス等で確立されているでは、ボークラファの技術及がそれに利用されている設備の利用が可能となり、他コノト化を図ることができる。

【りロリ4】モニで、リング「層」に4を放射線218によって浮露した後に所定が条件により現像が理を行うと、放射線218の暴露領域21%において、レビジン層214が選択的に除去され、図8%に対けですように、時村212の表面が露出し、それ以外の領域はレジスト層214によっ覆がれたままらが態となる。

【00053】続いて、ハダー、化されたいジスト層を1 4を一加熱して軟化させ、その表面展力によって、図8 D) に分すように側面を傾斜させる。

【0.096】次に [5/8](D) にi すように、ここ  $\nu i$  スト層2.14をマスクとして、エッチャント<math>2.20によ

って 基材212を所主の深さエッチングを行う。詳しては 異方性エッチング、例えば反応性イオンエーチング (RIF)などのドライエッチングを行う。

【0007】ここで、、デスト層214は側面が照料しているので、エッチ。でにより、この無地のレジテト層214が争々に小さらなって、基材212は徐々に露出していた。この露出した領域が連続的に往々にエッチングされている。こうして、基材212の連続的に往々にエッチンでされるので、エッチンで後の基材212の表面によ、国9(A)に示すように、台井中高部222が形成される。

【0098】そして、凸部0222上のいシフェ層214 を、心要であわば除去して、原盤224か得りわる。

【0000】本実施肝態によれば、原盤と24の出部と 22の所面がお肝をなす。これ原盤と24を、例1に示す原盤と00円10年に使用すれば、開口部が原面という。 大きになるように側面を傾斜させた関部と02を形成することができる。この関部202によれば、應光性材料 42を容易に確実に導き入れることができる。したかって、インフジェーナー・ドル制御が容易で、製造上の無 留まり付達しなるという時果を集する。

【り100】 この原盤に194は、本実施制修では、一日製造すればその後、耐外性の許可限り何度でも使用できるため経済的できる。また、原盤224の製造工程は、2枚目以降でディアロレンでアレイの製造工程において治略でき、工程数で減りおよび第二十十七分回途ことができる。

【0101】上記実施の形態では、基村212上に凹部 222を形成するに際し、すり型の10.2×を用いた か、放射線に暴露された領域が現像液に対して不溶化 し、放射線に暴露されていない領域が現像液により選択 的に除去可能となるネカ型の10.2×を用いても良く、 この場合には、上記マスプ216とはバターンが反転し たマスプが用いられる。からいは、マスプを使用せず に、、一寸光をらいは電子線によって直接1.2×を ター、れに暴露しても良い。

【の102】また、現像処理条件を調整することによ り、図8(3D) にデすように、パター、他されたレジア 主層は14の側面を傾斜させることが可能な場合には シジス:層は14を加熱する工程を省略してもよい。

【0103】きるいは、同101に、サファの変形網を定す。何同にデザサンク240は、放射線238の誘導部2445 生透過部246とを面するペープ・サンツである。生透過部246は、遊散部2445で離れるに後、可存々に放射線238の誘過率が高。なくように形成されている。同胞では、生透過部245を形成する運輸材に厚みを変化させることで、透過率を変化させているが、濃値によって透過率を変化させているが、濃値によって透過率を変化させているが、濃値によって透過率を変化させてより、このマスク240を使用すると、放射線2384 生透過部246を減衰されなかこも通過して、

・シスト優全34を暴露する。詳しくは、透過記242 たる進載部244に向けて、減衰率が高くなるように、 放射線238が手透過部246を透過する。それ結果、 應載部244に近つくに従れて、放射線238による暴 露が浅くなり、図10に示すように、側面が傾斜したシンスト層234を残す領域が暴露領域237となる。こ ですることでも、側面が傾斜したシジスト層とパターン 化を行うことができる。

【0104】 第4の実施形態 図11~図14~C・は、第4か実施形態に係るマイクロレンスアレイ基板及びその製造方法を示す図である。本実施形態では、図11に示すマイクロレンズアレイ基板300を製造する。マイクロレンズアレイ基板300に、四部302小形状において、図2 B・に示すマイクロレンズアレイ基板300に、四部302小形状に形成されて、図2 B・に示すマイクロレンズアレイ基板32と異なる。すなわれ、四部302は、内側面のそうを間口端部がデーバ形状に形成されている。このように関口端部がデーバ形状とたった開部300でによれば、底面に比べ開口部が広くなっているので、画素密度が高くなっても、遮光性材料42(図2(B)参照 を確実に充填することができる。この形状の四部202を形成するには、立ち上がりの基端部において台形と同様に傾斜した側面を有する凸部を有する原盤を使用する

【0105】図12 :A) ~図14 (C) は、凹部30 2を形成するための原盤を形成する工程を示す図である。

【0106】まず、図12・A1に示すように、裏材3 12上にマスク層314を形成する。墓材312は、エッチング可能な材料であれば特に限定されるものではないが、シリコン又は石英は、高精度のエッチングが容易であるため好適である。

【0107】マスク圏314は、基材312に強固に一体化して剥離しにくいものが好ましい。例えば、基材312かシリコンで形成されている場合には、その表面を執験化させて形成したシリコン酸化膜(SiOェルをマスク圏314とすることができる。これによれば、マスク圏314は、基材312と強適に一体化する。あるいは、基材312が金属、石英、カラススはシリコンである場合には、その表面にA1、Ni、Cr、W、Pt、Au、1r、Tiのいずれかで膿を形成し、これをマスク圏314としてもよい。

【0108】次に、図12 8 に示すように、基材3 121に形成されたマスク層3141にレジスト層31 6を形成する。レジスト層316の材料及びその形成方 占は、上述した第3万実施形態で適用できるものを選択 てきる。

【0109】続いて、図12 C に示すように マスク318をいび以下署516の上に配置し、マスク318を全してレンスト署316の新定領域のみを放射課320によって集露する。マスク318は、最終的に製造されて展盤582で設備34 図14 C 参照 ・

形成にご要とされる領域におって、放射線52005透過するようにパターン形成されたものである。マスタ318における放射線透過部は、プラックマトックスの形状に応じた株式をなして、る。アラックマトックスの形状は、モナイク配列、ボッタ配列又はストライク配列などの画素配列に向したものである。放射線としては波長200mm~500mm~500mm~6億域の光を用いることが好ました。

【0110】そして、レジスト層316を放射線320によって装露した後に所定の条件により現像処理を行うと一放射線320の装露領域317において、レジスト層316が選択的に除去され、図12(D)に示すように、基材に12の表面が露出し、それ以外の領域はレジスト層316により概われたままの状態となる。

【0111】続いて、パターン化されたンジスト層 3 1 6 を、加熱して軟化させ、その表面張力によって - 図1 2 (E・に示すように側面を傾斜させる。

【0112】次に、図12(E)に示すように、側面が 傾斜した1 ジスト層216をマスタとして、エッチャント322によって、マスク層314をエッチングする。 詳しくは、異方性エッチング、例えば反応性ドナンエッチング(FIE)などのドラィエッチングを行う

【0113】ここで、レジスト層316は側面が傾斜しているので、エッチングにより、この形状のンジタト層316が徐々に小さくなって。基材312は徐々に露出していく、この露出した領域が連続的に徐々にエッチングされていく。こうして、基材312が連続的に徐々にエッチンクされるので、マスタ層314は「図13

(A・に示すように台形をなす。マスク層314からは、基材312の表面の一部が露出する。詳しくは、マスク層314の周囲を囲んで、基材312の表面の一部が露出する。この露出部は、ブラックマトリニスの形状に応じた枠状をなしている。ブラックマトリニスの形状に応じた枠状をなしている。ブラックマトリニスの形状は、モザイク配列、デルタ配列又はストライで配列などの画素配列に応じたものである。また、基材:12の表面の一部が露出した時点で、エッチングを停止することが好ましい。

【0114】モレて、マスク層314上のシビスト層3 16を必要であれば除去し、例13(B)に示すよう に、エッチャント324によって、基材312における マスケ層314かみ露出した部分をエ・チングする。

【り113】ここでは、基材を10の表面に垂直にエッチンでが進む高異が性エッチングであって、基材を10 をエッチングするかマスク層を14をエッチングしたく い高選択性エッチングが行われる。

【の116】こうして、エッチングがされると、2213 (C) に示すように、基材312に原盤形成用四部32 るづ形成される。原盤形成用正部326は、ブラッカマ トンケスケ形形に応じた枠状をなしている。マラットマ トンケスケ形形は、モサイケ配列、デッタ配列又はスト ライブ配列などの画素配列に応じたものである。

【0117】また、原盤形成用門部326にて囲まれる 凸部625上には、台形トマスク層314が残されてい う。ここで 凸部3254側面は垂直に立ち上がり、マ 二ク層314の側面は傾斜してデーが状をなしている。 このことから、原盤形成用凹部326の側面は、底面か 三垂直に立ち上がり 開口端部において存々に径が大き してる方向に拡充して傾斜するデード面となっている。

【0118】続、て、図14 (A) に示すように 基材 312における原盤形成用凹部325が形成されている 面上に、金属膜328を形成して、その表面を導電

(体)化する。金属膜328 - しては。例えば、エーケル(包))を300~1000 オングフトコーム(1 0 円 m )の厚みて形成すればよい。金属膜328の形成 
方法としては、スパックリング、CVD、蒸着。無電解 
イーキ法等の方法を用いることが可能である。なお、基 
村312の表面が、この後の電気鋳造法による金属層の 
升成において記要な導電性を有していまは、この導電化 
は主要である。

【0119】モミア、金属膜328を陰極!し、チープ 物を思いはボール状のNiを陽極として電気鋳造法によった。にNiを電番をせて、[]14 - Fi に示すよう に、厚い金属層330を形成する。電気メリキ液の一例 を知ずに示す。

【0120】アルコーミン酸エッケル・550g/ 1 けで酸 - 35g/ 1 塩化エッケル - 5g/ 1 マペニンご剤 - 20mg/ 1

続いて「図14(C)に示すように、金属膜328及び 金属層330を、基材312元行動離し、必要があれば 洗浄する等して、無盤332が得られる。金属膜328 は、必要に応して剥離処理を施して、原盤332が小陸 去してもよい。

【0121】原盤332には、基村312の原盤形成用 関部326に対応して、凸部334か形成されている。 詳しては、原盤形成用距部326か、開口端部におい て、外方向に向けて径かわき。なるように傾斜するサー が比をなしているので、これに対応して、凸部334に は、基端部に対いて、先端方向に向けて存まに径かいた でもも方向に傾斜するテーが面が形成されている。

【0102】本実施升齢によれば、原盤さ32の凸部3 シ4が上述した用紙をです。この原盤332を、図1に ボで原盤20の代わいに使用すれば、関ロ端部において 経が大きっなきように傾斜した関節302を用成するこ ができる。この国第302によれば、進光性材料42 を容易に確実に導き入れることができる。したがって、 インタジェットへいたの制御が容易で、製造上の準留ま を消息くなるという効果を奏する。

【U123】1で原盤332は、本実施圧態では、一旦製造すればその後、耐久性の許す限り何度でも使用でき

るため経済的である。また、原盤332の製造工程は、 で枚目以降のマイニロレンでアレイの製造工程において 省略でき、工程数の減少および低コスト化を図ることが できる

【0124】图15は、本発明を適用した液晶プロジェクタの一部をがす図である。この液晶プロジェクタは、上述した第2の実施形態に係る方法により製造されたマイクコレンでアレイ基板132を組み込んだテイトバルブ12、光源でしてのランプ22を育する。

【0125】マイクロレンドアレイ基板132は、レンド134はデンド2から見て関わになるように配置されている。そして、デラックマトラクスとなる遮光層138側の補強板148上には、透明な共通電極162及び配向膜164が積層されている。

【0126】ライトハクフ1には、配向膜164からキャーアをあけて、TFT基板174か設けられている。 TFT基板174には、透明な個別電極170及び薄膜トラ、ブスタ172か設けられており、これらの上に配 向膜168が形成されている。また、TFT基板174 は、配可膜168を配向膜164に対向させて配置されている。

【0127】配向膜164、168間には、液晶166 が起入されており、薄膜トランシスタ172によって制 御される電圧によって、液晶166が駆動されるように なっている。

【9123】この液晶でロッチ、空によれば、コンデタから照射された光3か、各画素毎にレンズ134にで集 光するので、明らい側面を表示することができる。ま た、遮光層138かフラックマトリクコとなるので、画 素間のコレトラクトを向上させることができる。

#### [0129]

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】図1 (A) 〜図1 (C) は、第1 実施刑態に係るサイクロ10 グア1 イ基板の製造方法を示す即である。

【図2】図2(A)及び図2 「B)は、第1実施形態に任みマイクロレンプアレイ基板の製造方法を示す図である。

【図3】図3 A) ト図3 (C) は、第1 実施刑態に係 キャイプロレンプアレイ基板の製造方法を手す図であった。

【図4】図4 : A ( 及び図4 : 15) は 第1実施刑態に 係るマイクロ11 プアレイ基板小製造方法をデオ図である。

【図3】図3・A)~図3 C)は、第2実施刑能に係るマイクロレンプアレイ基权の製造方法を示す図である。

【図6】図6 (A) 〜図6 (C) は、第2実施升態に係るマイテコレンズアレイ基板の製造方法を示す図である

【図り】図りは、第300実施形態に係るマイクロシンでアンマ基板をイタ図である。

【図8】図8 A 下図8 D は 第37実施形態に 停ませるため、ペアンタ基板の製造できか形す図でを で

【図9】図9 A 及1回9 B す 第三の実施形態 に係るマイクロ...アドン・基板で製造が出身示す図で まる

【図10】図10は、第30年施州町で使用されるマスカル変形例を・1907を3

【図11】図(1 ま 第4)実施も修り任させイクロレンズアレイ基地をデオ区である。

【図12】図12 A 1312 F は 第4の実施 形態に係るマナウルに、アプレ・基地で製造で法を示す 図である。

【図13】図13 A トビ13 (-) (1 第4の実施 形態に係るサーツ・1 オイ1・基板・製造や法を示す 梁でをる

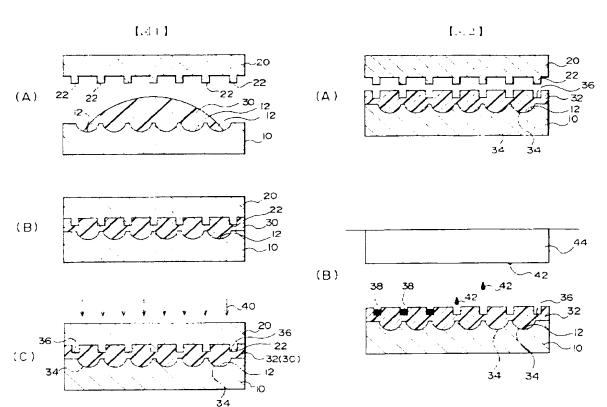
【図14】図:4 A・トバ14 C に 第4の実施

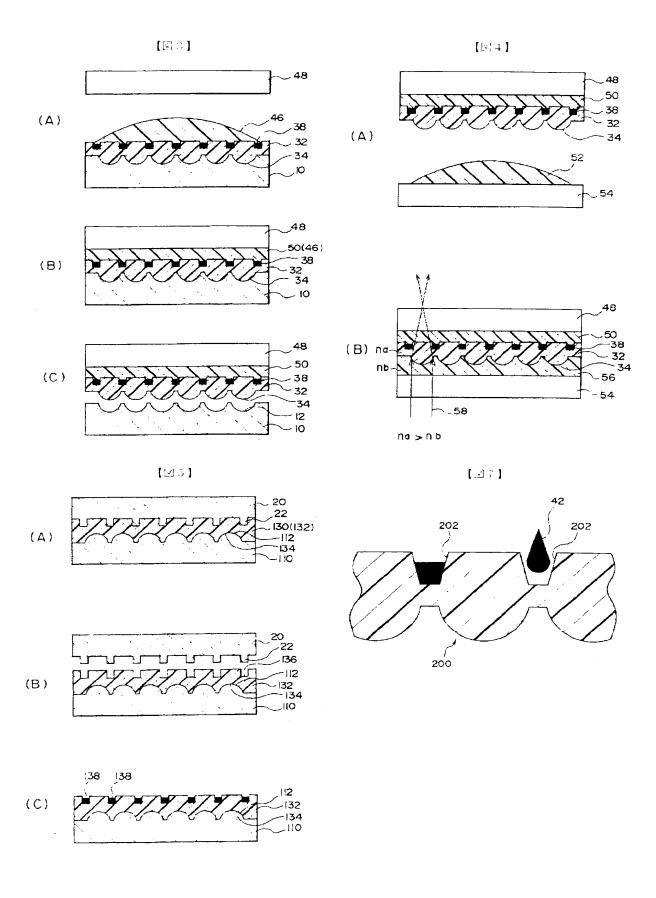
一彩軽に係るマイフロシンスでジア基板の製造を出を示す。 図である。

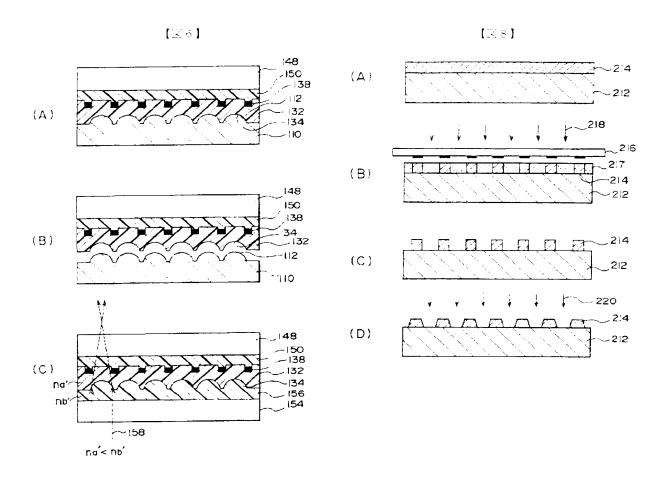
【図15】図15は、**:**菊明を適用して製造されたマイクコンシステレイ基板へ組みでまれた液晶プロジェクタを示す②である

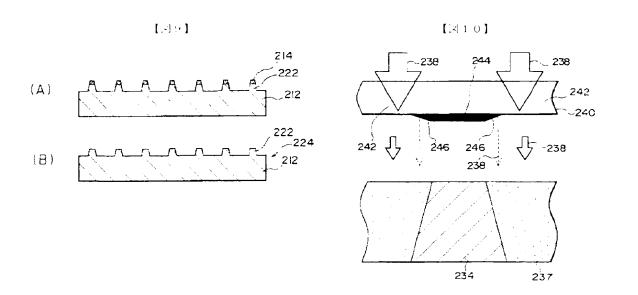
【符号汇説明】

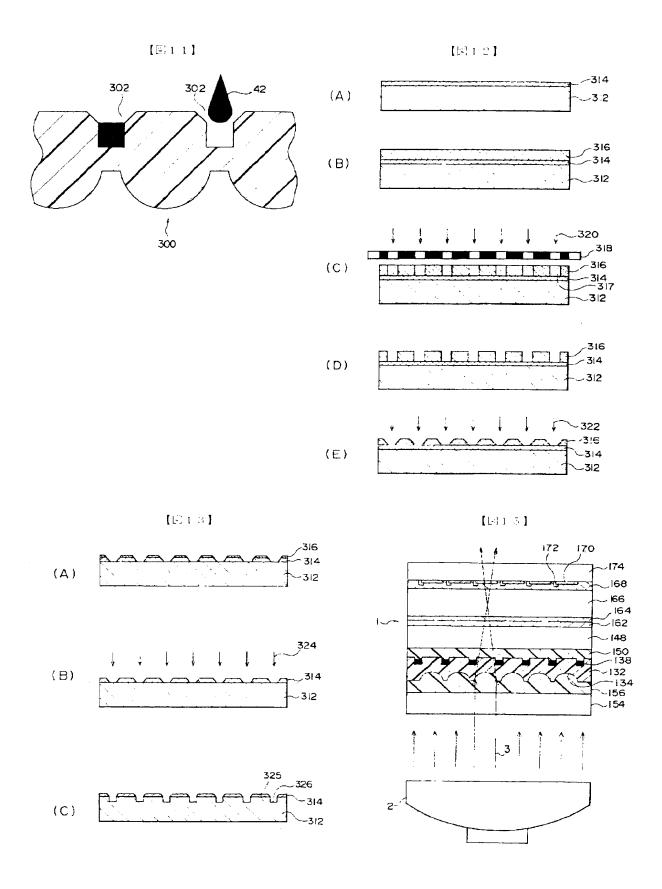
- 10 無盤
- 12 曲面部
- 2.0 原盤
- 30 基板前駆体
- 52 マイクロレンズアレイ基板
- 54 153
- 5-6 四部
- 5.8 遮光性層
- 4.2 避免性材料
- 48、54 補強板
- 50、56 保護膜
- 58 ±





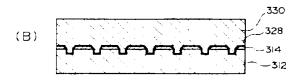


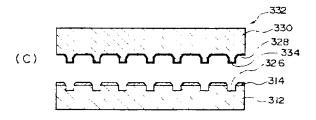




[314]







		•